

Title (en)
METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING PURE ELEMENTAL IODINE.

Title (de)
VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON REINEM ELEMENTAREM JOD.

Title (fr)
PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D'IODE ELEMENTAIRE PURE.

Publication
EP 0494150 A1 19920715 (EN)

Application
EP 90911944 A 19900820

Priority
CA 613953 A 19890928

Abstract (en)
[origin: WO9104940A1] A method and device for producing thermodynamically free iodine in which a source material containing thermodynamically free iodine is introduced to one side of an iodine solving solid barrier through which the thermodynamically free iodine passes by dispersion to the other side of the solid barrier until an equilibrium of thermodynamically free iodine vapour pressure is reached across the barrier. In a preferred embodiment of the invention, the degree to which the thermodynamically free iodine disperses to the other side of the iodine solving solid barrier may be controlled by means which reduce the vapour pressure of thermodynamically free iodine such as the variation of temperature of the iodine source material or of the other side of the barrier as well as the use of an iodine complexing compound in conjunction or in combination with the source material.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé et à un dispositif servant à produire de l'iode thermodynamiquement libre, dans lesquels une substance source contenant de l'iode thermodynamiquement libre est introduite d'un côté d'une barrière solide dissolvant l'iode, à travers laquelle l'iode thermodynamiquement libre passe par dispersion pour atteindre l'autre côté de la barrière solide, jusqu'à ce qu'un équilibre de la pression de vapeur de l'iode thermodynamiquement libre soit atteint à travers la barrière. Dans un mode de réalisation préféré de la présente invention, le degré avec lequel l'iode thermodynamiquement libre se disperse pour passer de l'autre côté de la barrière solide dissolvant l'iode peut être régulé par des moyens qui réduisent la pression de vapeur de l'iode thermodynamiquement libre et qui consistent par exemple en une variation de la température de la substance source d'iode ou de l'autre de la barrière, ainsi qu'en l'utilisation d'un composé de complexion d'iode en conjonction ou en combinaison avec la substance source.

IPC 1-7
C01B 7/14

IPC 8 full level
A01N 59/12 (2006.01); **B01D 61/36** (2006.01); **C01B 7/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)
A01N 59/12 (2013.01 - EP); **B01D 61/363** (2022.08 - EP US); **C01B 7/14** (2013.01 - EP)

Citation (search report)
See references of WO 9104940A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9104940 A1 19910418; AU 6153690 A 19910428; AU 633616 B2 19930204; BR 9007705 A 19920721; CA 1340947 C 20000404; EP 0494150 A1 19920715; FI 921354 A0 19920327; FI 921354 A 19920327; HU 9201028 D0 19920828; HU T60696 A 19921028; JP H05500354 A 19930128; NO 308697 B1 20001016; NO 921168 D0 19920325; NO 921168 L 19920529

DOCDB simple family (application)
CA 9000265 W 19900820; AU 6153690 A 19900820; BR 9007705 A 19900820; CA 613953 A 19890928; EP 90911944 A 19900820; FI 921354 A 19920327; HU 102892 A 19900820; JP 51116690 A 19900820; NO 921168 A 19920325